型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)													外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{fe}(real)* (Ω)		
2SC2232																							
〃 2233	東芝	PA	Si. T	200	5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	170	30~150	5	1 A	5	−500					8 *	80	50	268	
〃 2234	〃	〃	Si.EP	35	3.5	10A	70W (Tc=25°C)	150	2mA	15	>10	5	5 A	10	−400	P_o>40W, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=10W)				300 *	<160		316	
〃 2235	〃	〃	Si. E	120	5	800	900	150	0.1	120	80~240	5	100	5	−100					120 *	<30		241	2SA965 とコンプリ
〃 2236	〃	〃	〃	30	5	1.5A	900	150	0.1	30	100~320	2	500	2	−500					120 *	<30		241	2SA966 とコンプリ
〃 2237	三菱	〃	Si. EP	35	4	2 A	20W (Tc=25°C)	175	500	25	50	10	100			P_o=7.5W, η=65% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.25W)							272	
〃 2238	東芝	RF.PA	Si. E	160	5	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	160	70~240	5	100	10	−100					100 *	25	4 *	268	2SA968 とコンプリ
〃 2239	〃	〃	〃	160	5	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	160	70~240	5	100	10	−100					100 *	25	4 *	99	2SA969 とコンプリ
〃 2240	〃	AF.LN	〃	120	5	100	300	125	0.1	120	200~700	6	2	6	−1	NF< 6 dB (f=10Hz, 6V, 0.1mA)			NF<2dB (f=1kHz)	100 *	3		138	
〃 2241	〃	PA	Si. T	300	7	150	20W (Tc=25°C)	150	1	240	40~170	10	50	10	−30					>50 *	3.8	15	268	
〃 2242	〃	〃	〃	300	5	150	25W (Tc=25°C)	150	1	240	40~170	10	50	50	−20					50 *	5.5		268	
〃 2243	富士電機	SW	Si.TP	450	7	5 A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	2 A			t_{on}< 1 μS, t_f= 1 μS t_{stg}< 2 μS							102	
〃 2244	〃	〃	〃	450	7	8 A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	3 A			t_{on}< 1 μS, t_f= 1 μS t_{stg}< 2 μS							102	
〃 2245	〃	〃	〃	450	7	10A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	4 A			t_{on}< 1 μS, t_f= 1 μS t_{stg}< 2 μS							102	
〃 2246	〃	〃	〃	450	7	15A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	6 A			t_{on}< 1 μS, t_f= 1 μS t_{stg}< 2 μS							102	
〃 2247	〃	〃	〃	450	7	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	2 A			t_{on}< 1 μS, t_f= 1 μS t_{stg}< 2 μS							321	
〃 2248	〃	〃	〃	450	7	8 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	3 A			t_{on}< 1 μS, t_f= 1 μS t_{stg}< 2 μS							321	
〃 2249	〃	〃	〃	250	7	30A	200W (Tc=25°C)	150	1 mA	250	>10	5	15A			t_{on}< 2 μS, t_f< 1 μS t_{stg}< 4 μS							266	
〃 2250	〃	〃	〃	450	7	30A	200W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	15A			t_{on}< 2 μS, t_f< 1 μS t_{stg}< 4 μS							266	
〃 2251	富士通	PA	Si.EP	45	3.5	500	7 W (Tc=25°C)	175	100	20	50	5	200			P_o=1.8W (f=900MHz, V_{CE}=18V, P_i=0.5W)							159	
〃 2252	〃	〃	〃	45	3.5	1 A	12W (Tc=25°C)	175	200	20	50	5	500			P_o=4.5W (f=900MHz, V_{CE}=18V, P_i=1.5W)							159	
〃 2253	〃	〃	〃	45	3.5	2 A	25W (Tc=25°C)	175	400	20	50	5	1 A			P_o= 9 W (f=900MHz, V_{CE}=18V, P_i= 4 W)							159	
〃 2254	〃	〃	〃	45	3.5	4 A	40W (Tc=25°C)	175	800	20	50	5	3 A			P_o=12W (f=900MHz, V_{CE}=18V, P_i= 6 W)							159	
〃 2255	〃	〃	〃	45	3.5	6 A	65W (Tc=25°C)	175	1.2mA	20	50	5	5 A			P_o=22W (f=900MHz, V_{CE}=18V, P_i=10W)							329	
〃 2256	サンケン	〃	Si.TMe	200	6	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	200	60	4	5 A	12	−500					10 *	110	18 *	102	
〃 2257	松下	〃	Si.EP	180	5	50	1 W	150	1	100	170	5	10	10	−10					80 *	2	70	222	
〃 2258	〃	AF. RF	Si.TP	250	7	100	1 W	150	100	250	>40	20	40	10	−10					100 *	2.3		222	
〃 2259	三菱	LN. Diff	Si. EP	100	5	50	200/unit	125	0.1	70	250~700	6	1	6	−1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0				100 *	1.8		274B	2素子複合
〃 2260	サンケン	PA	Si.TMe	160	6	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	100	>30	4	3 A	12	−500					15 *			102	2SA980 とコンプリ
〃 2261	〃	〃	〃	180	6	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	120	>30	4	3 A	12	−500					15 *			102	2SA981 とコンプリ

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw